

<HVIC>

# M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

## 概要

M81749FP は、600V 耐圧で 3 相ブリッジ接続の IGBT/MOSFET 駆動用として設計された半導体集積回路です。

## 特長

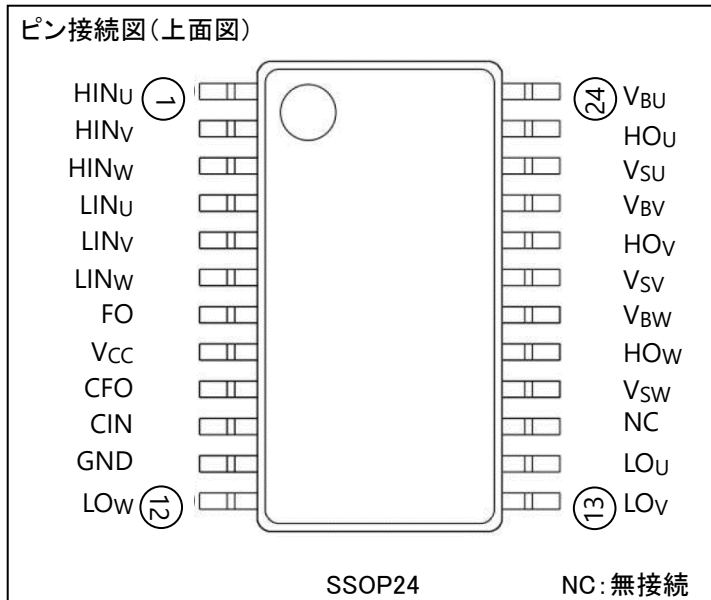
- 耐圧.....600V
- 出力電流.....+200mA/-350mA (標準)
- 3 相ブリッジ駆動
- 電源電圧低下保護回路内蔵
- 短絡保護回路内蔵
- 24 ピン SSOP パッケージ

## 用途外形:

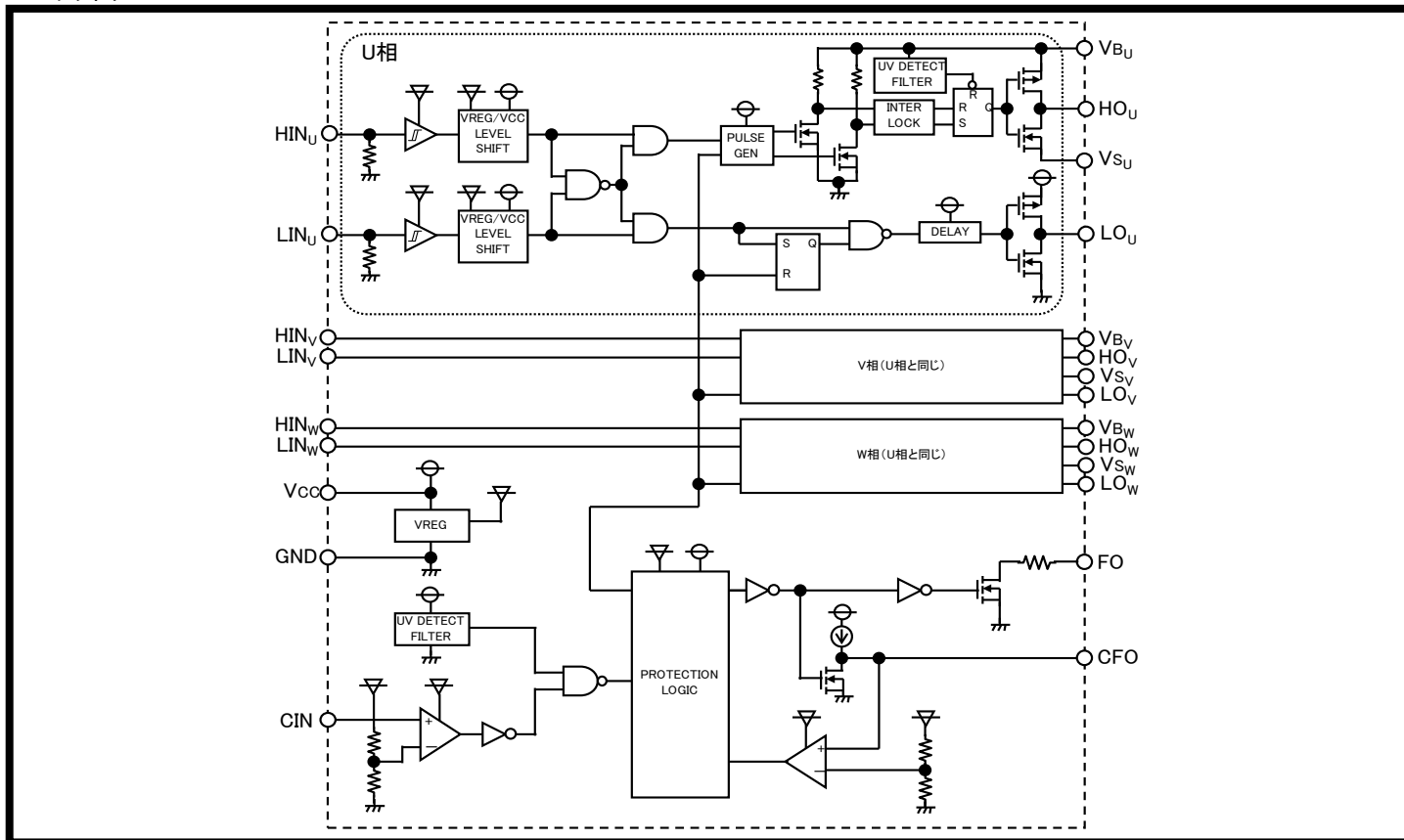
エアコン・冷蔵庫・洗濯機・汎用インバータ・AC サーボ等

IGBT/MOSFET 駆動

ピン接続図(上面図)



## ブロック図



## M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

絶対最大定格 (指定の無い場合は、周囲温度  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )(\* : U,V,W 相を示す)

記号	項目	条件	定格値	単位
$V_{B*}$	ハイサイド・フローティング電源絶対電圧		-0.5~624	V
$V_{S*}$	ハイサイド・フローティング電源オフセット電圧		$V_{B*}-24\sim V_{B*}+0.5$	V
$V_{BS}$	ハイサイド・フローティング電源電圧	$V_{BS}=V_{B*}-V_{S*}$	-0.5~24	V
$V_{HO*}$	ハイサイド出力電圧		$V_{S*}-0.5\sim V_{B*}+0.5$	V
$V_{CC}$	ローサイド固定電源電圧		-0.5~24	V
$V_{LO*}$	ローサイド出力電圧		-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
$V_{IN*}$	ロジック入力電圧	HIN*,LIN*端子	-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
$V_{FO}$	FO 出力電圧	FO 端子	-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
$I_{FO}$	FO 出力電流	FO 端子	0~1	mA
$V_{CIN}$	電流センス入力電圧	CIN 端子	-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
$V_{CFO}$	CFO 入出力電圧	CFO 端子	-0.5~ $V_{CC}+0.5$	V
$P_d$	許容損失	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ ,基板実装時	1.3	W
$K\theta$	熱低減率	$T_a>25^{\circ}\text{C}$ ,基板実装時	10.4	mW/ $^{\circ}\text{C}$
$R_{th(j-c)}$	ジャンクション-ケース間熱抵抗		96	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$T_j$	接合部温度		-40~150	$^{\circ}\text{C}$
$T_{opr}$	動作周囲温度		-40~125	$^{\circ}\text{C}$
$T_{stg}$	保存温度	基板実装時	-40~150	$^{\circ}\text{C}$
TL	半田耐熱(リフロー)	鉛フリー対応仕様	255:10s, max260	$^{\circ}\text{C}$

推奨動作条件 (\* : U,V,W 相を示す)

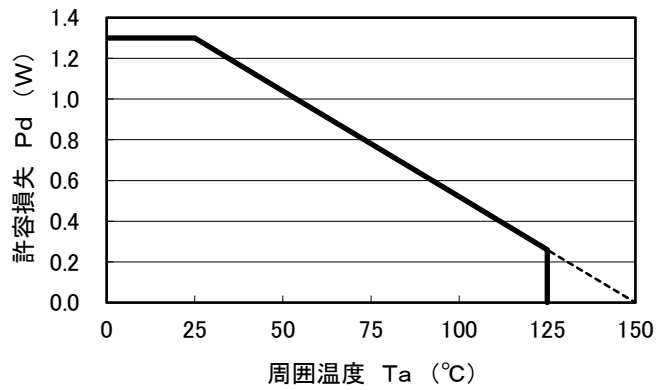
記号	項目	条件	定格値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{B*}$	ハイサイド・フローティング電源絶対電圧		$V_{S*}+10$	—	$V_{S*}+20$	V
$V_{S*}$	ハイサイド・フローティング電源オフセット電圧	$V_{B*}>10\text{V}$	-5	—	500	V
$V_{BS}$	ハイサイド・フローティング電源電圧	$V_{BS}=V_{B*}-V_{S*}$	10	—	20	V
$V_{HO*}$	ハイサイド出力電圧		$V_{S*}$	—	$V_{B*}$	V
$V_{CC}$	ローサイド固定電源電圧		10	—	20	V
$V_{LO*}$	ローサイド出力電圧		0	—	$V_{CC}$	V
$V_{IN*}$	ロジック入力電圧	HIN*,LIN*端子	0	—	$V_{CC}$	V
$V_{FO}$	FO 出力電圧		0	—	$V_{CC}$	V
$V_{CIN}$	電流センス入力電圧		0	—	$V_{CC}$	V
$V_{CFO}$	CFO 入出力電圧		0	—	$V_{CC}$	V

※適正な動作をさせるには推奨条件内での使用が重要です。

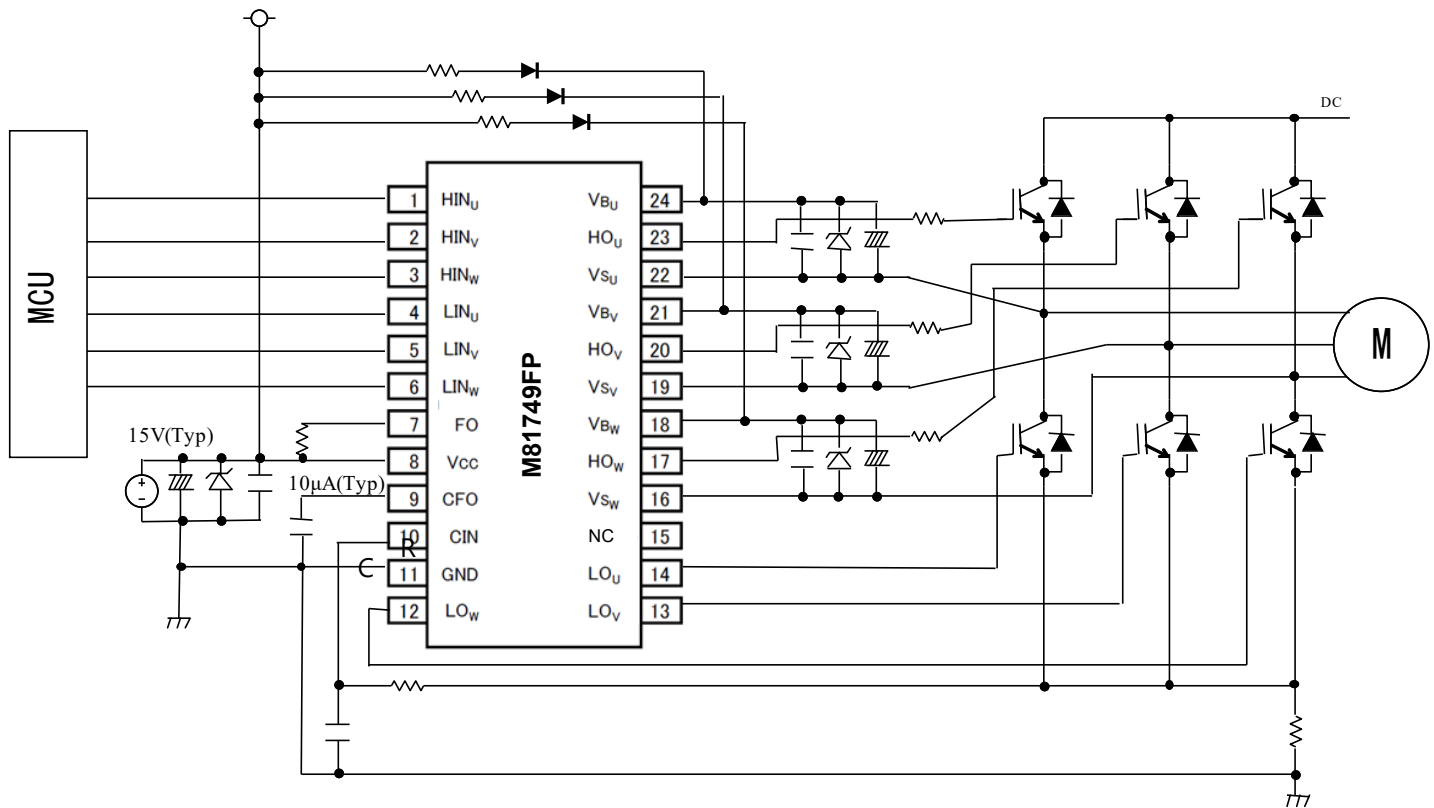
# M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

熱低減曲線（最大定格）



標準接続図



・CIN: 使用されるパワー素子の短絡耐量(時間)とHVIC及びパワー素子の遮断時間をご考慮の上、RC定数を設定願います。

電气的特性 (指定の無い場合は、 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=V_{BS}(=V_{B*}-V_{S*})=15\text{V}$ )(\* : U, V, W 相を示す)

記号	項目	条件	定格値			単位
			最小	標準*1	最大	
$I_{FS}$	フローティング電源漏れ電流	$V_{B*}=V_{S*}=600\text{V}$ , 1 相当り	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
$I_{BS}$	$V_{BS}$ 電源スタンバイ電流	$HIN*=LIN*=0\text{V}$ , 1 相当り	—	0.2	0.5	$\text{mA}$
$I_{CC}$	$V_{CC}$ 電源スタンバイ電流	$HIN*=LIN*=0\text{V}$	0.5	1.0	2.0	$\text{mA}$
$V_{OH}$	H レベル出力電圧	$I_O=-20\text{mA}$ , $HO*$ , $LO*$ 端子	13.6	14.2	—	$\text{V}$
$V_{OL}$	L レベル出力電圧	$I_O=20\text{mA}$ , $HO*$ , $LO*$ 端子	—	0.3	0.6	$\text{V}$
$V_{IH}$	H レベル入力しきい値電圧 *2	$HIN*$ , $LIN*$ 端子	2.7	—	—	$\text{V}$
$V_{IL}$	L レベル入力しきい値電圧 *3	$HIN*$ , $LIN*$ 端子	—	—	0.8	$\text{V}$
$I_{IH}$	H レベル入力バイアス電流	$HIN*$ , $LIN*=5\text{V}$	—	25	100	$\mu\text{A}$
$I_{IL}$	L レベル入力バイアス電流	$HIN*$ , $LIN*=0\text{V}$	—	—	2	$\mu\text{A}$
$V_{BSuvr}$	$V_{BS}$ 電源 UV リセット電圧		7.0	8.4	9.8	$\text{V}$
$V_{BSuvt}$	$V_{BS}$ 電源 UV トリップ電圧		6.5	7.85	9.0	$\text{V}$
$V_{BSuvh}$	$V_{BS}$ 電源 UV ヒステリシス電圧		0.3	0.55	—	$\text{V}$
$tV_{BSuv}$	$V_{BS}$ 電源 UV フィルター時間		—	7.5	—	$\mu\text{s}$
$V_{CCuvr}$	$V_{CC}$ 電源 UV リセット電圧		7.0	8.4	9.8	$\text{V}$
$V_{CCuvt}$	$V_{CC}$ 電源 UV トリップ電圧		6.5	7.85	9.0	$\text{V}$
$V_{CCuvh}$	$V_{CC}$ 電源 UV ヒステリシス電圧		0.3	0.55	—	$\text{V}$
$tV_{CCuv}$	$V_{CC}$ 電源 UV フィルター時間		—	7.5	—	$\mu\text{s}$
$I_{OH}$	出力 H レベル負荷短絡電流	$V_O=0\text{V}$ , $V_{IN}=5\text{V}$ , $PW<10\mu\text{s}$ , *4	120	200	—	$\text{mA}$
$I_{OL}$	出力 L レベル負荷短絡電流	$V_O=15\text{V}$ , $V_{IN}=0\text{V}$ , $PW<10\mu\text{s}$ , *4	250	350	—	$\text{mA}$
$R_{OH}$	出力 H レベルオン抵抗	$I_O=-20\text{mA}$ , $R_{OH}=(V_{CC}-V_{OH})/I_O$	—	40	70	$\Omega$
$R_{OL}$	出力 L レベルオン抵抗	$I_O=20\text{mA}$ , $R_{OL}=V_{OL}/I_O$	—	15	30	$\Omega$
$tdLH(HO)$	ハイサイドターンオン入出力伝達遅延時間	$HO*-V_{S*}$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	150	300	$\text{ns}$
$tdHL(HO)$	ハイサイドターンオフ入出力伝達遅延時間	$HO*-V_{S*}$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	130	230	$\text{ns}$
$trH$	ハイサイド立ち上がり時間	$HO*-V_{S*}$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	130	220	$\text{ns}$
$tfH$	ハイサイド立ち下がり時間	$HO*-V_{S*}$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	50	80	$\text{ns}$
$tdLH(LO)$	ローサイドターンオン入出力伝達遅延時間	$LO*-GND$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	150	300	$\text{ns}$
$tdHL(LO)$	ローサイドターンオフ入出力伝達遅延時間	$LO*-GND$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	130	230	$\text{ns}$
$trL$	ローサイド立ち上がり時間	$LO*-GND$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	130	220	$\text{ns}$
$tfL$	ローサイド立ち下がり時間	$LO*-GND$ 間 $CL=1000\text{pF}$	—	50	80	$\text{ns}$
$\Delta tdLH$	ターンオン入出力伝達遅延時間マッチング	$ tdLH(HO)-tdLH(LO) $	—	0	30	$\text{ns}$
$\Delta tdHL$	ターンオフ入出力伝達遅延時間マッチング	$ tdHL(HO)-tdHL(LO) $	—	0	30	$\text{ns}$
$V_{FOH}$	FO H レベル出力電圧	$CIN=0\text{V}$ , $10\text{k}\Omega$ to $V_{CC}$	14.9	15.0	—	$\text{V}$
$V_{FOL}$	FO L レベル出力電圧	$CIN=1.5\text{V}$ , $I_{FO}=1\text{mA}$	—	—	0.95	$\text{V}$
$I_{FOH}$	FO リーク電流	$CIN=0\text{V}$ , $V_{FO}=V_{CC}$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
$tW_{FOP}$	FO パルス幅	$CFO=22\text{nF}$ 時	7	11	15	$\text{ms}$
$t_{SC1}$	SC 遮断時間1	$CIN:0\text{V}\rightarrow 1.5\text{V}$ , $CIN$ to $OUT$	400	620	900	$\text{ns}$
$t_{SC2}$	SC 遮断時間2	$CIN:0\text{V}\rightarrow 1.5\text{V}$ , $CIN$ to $FO$	350	520	750	$\text{ns}$
$t_{SC3}$	SC フィルタ時間	$CIN:0\text{V}\rightarrow 1.5\text{V}$ パルス	100	380	—	$\text{ns}$
$V_{SC}$	SC トリップ電圧	$FO:H\rightarrow L$ 時の $CIN$ 端子電圧	0.8	1.0	1.2	$\text{V}$
$V_{CFOT}$	CFO しきい値電圧		4.5	5.0	5.5	$\text{V}$
$I_{CFO}$	CFO 電流	$CFO=0\text{V}$	-14	-10	-7	$\mu\text{A}$

\*1 標準値であり、これを保証するものではありません。

\*2 入力”H”は定格値の最小に記載の値以上の電圧として下さい。

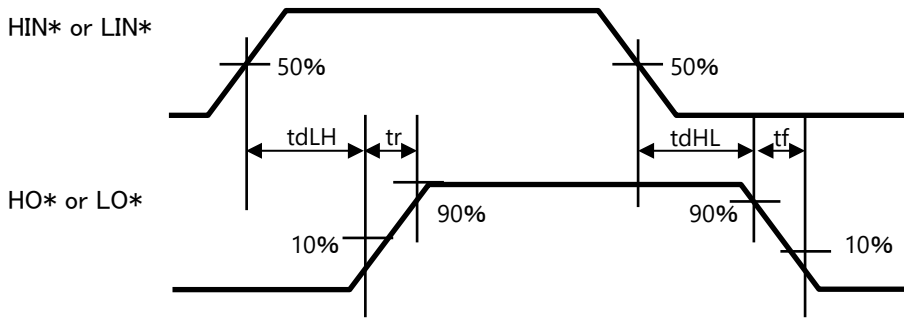
\*3 入力”L”は定格値の最大に記載の値以下の電圧として下さい。

\*4 短絡パルスが連続的にかかる状態とはしないで下さい。

# M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

## 入出力タイミング (\*:U,V,W 相を示す)



## 機能表 (\*:U,V,W 相を示す) (X:H or L)

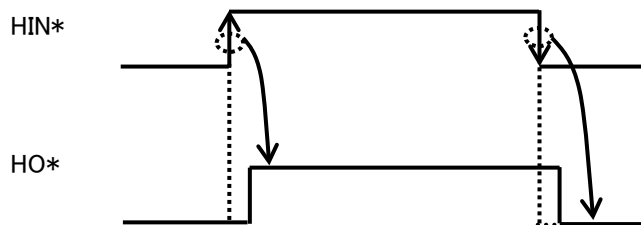
HIN*	LIN*	V <sub>BS</sub> UV	V <sub>CC</sub> UV	CIN	HO*	LO*	FO	備考
H→L	L	H	H	L	L	L	H	HO*,LO*出力 LOW
H→L	H	H	H	L	L	H	H	LO*出力 HIGH
L→H	L	H	H	L	H	L	H	HO*出力 HIGH
L→H	H	H	H	L	L	L	H	HO*,LO*出力 LOW
X	L	L	H	L	L	L	H	V <sub>BS</sub> UV 遮断 HO*出力 LOW
H→L	H	L	H	L	L	H	H	V <sub>BS</sub> UV 遮断 LO*出力 HIGH
L→H	H	L	H	L	L	L	H	V <sub>BS</sub> UV 遮断 HO*,LO*出力 LOW
H→L	X	H	L	L	L	L	L	V <sub>CC</sub> UV 遮断 LO*出力 LOW
L→H	X	H	L	L	L	L	L	V <sub>CC</sub> UV 遮断 HO*,LO*出力 LOW
X	X	X	X	H	L	L	L	SC 遮断 HO*,LO*出力 LOW

注) V<sub>BS</sub>UV, V<sub>CC</sub>UV の”L”状態は、UV 遮断となる電圧を表します。 CIN の”H”状態は、SCを検知する電圧を表します。

HIN\*, LIN\*入力同時”H”時、HO\*, LO\*出力ともに LOW となります。(\*:U,V,W 同相)

X(HIN\*): L→H or H→L。 X(LIN\*): H or L。

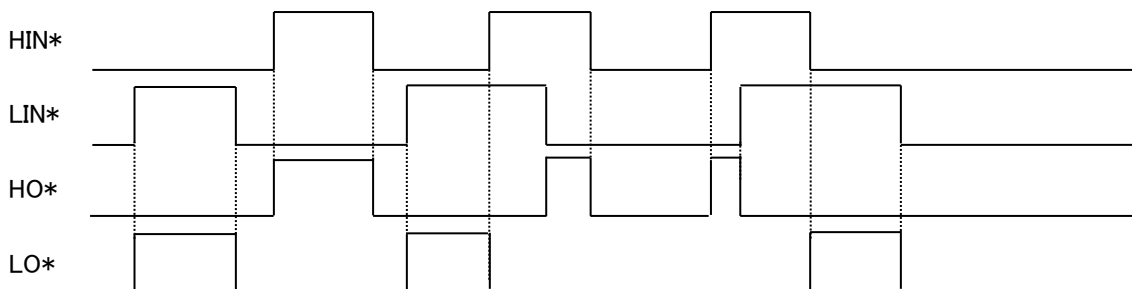
出力 HO\*は入力信号 HIN\*のハイ/ロー変化に応じて、オン/オフが変わります(エッジトリガー方式)。



## 機能概要 (\*:U,V,W 相を示す)

### 1. 入出力動作

HIGH ACTIVE。ただし、HIN\*, LIN\*入力同時”H”時は HO\*, LO\*出力ともに LOW となります(インターロック機能)。

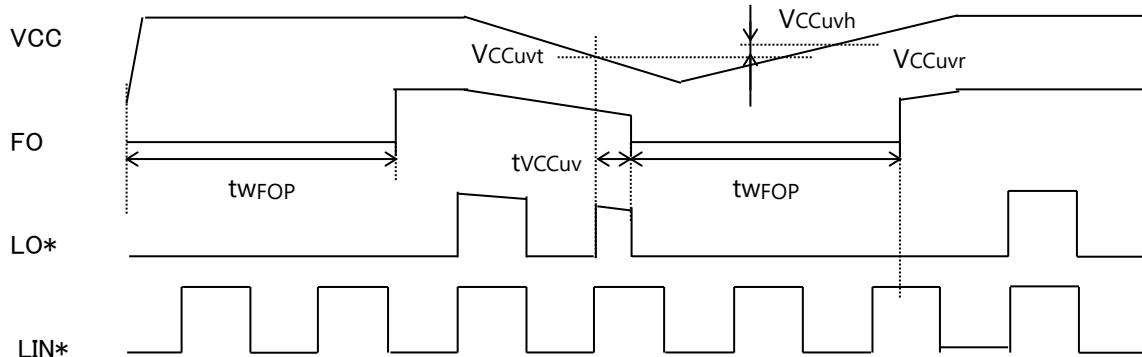


# M81749FP

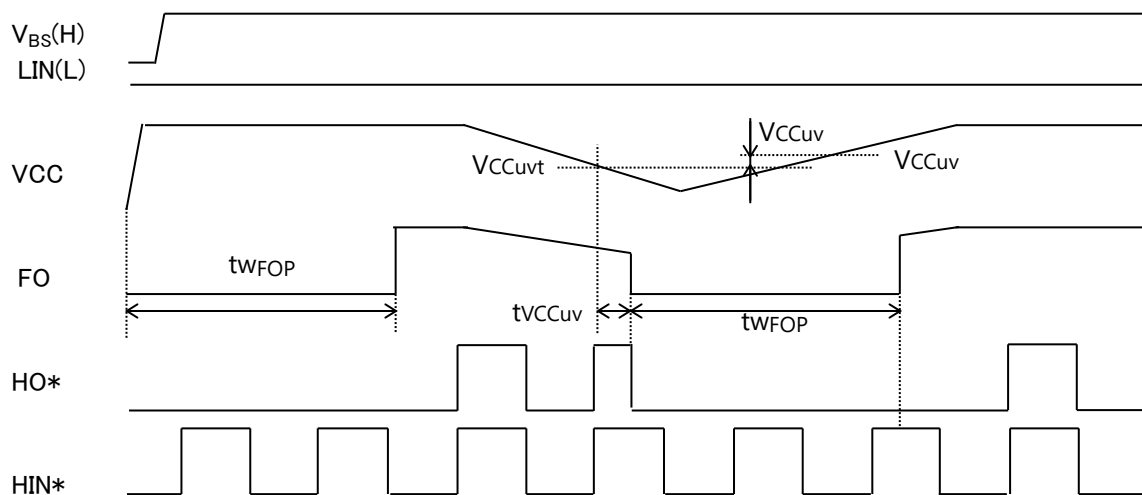
600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

## 2. 電源電圧低下保護動作

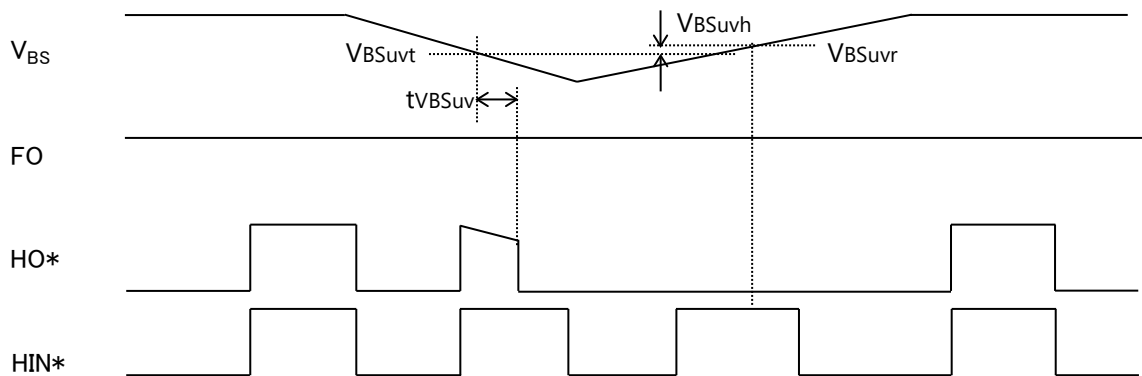
$V_{CC}$  電源電圧が UVトリップ電圧( $V_{CCuvt}$ )より低下した状態が継続すると、UV フィルター時間経過後に FO 出力を LOW とすると共に、LO\*出力を LOW とします。 $V_{CC}$  電源電圧が UV リセット電圧より高くなると、FO パルス時間経過後、FO 出力が HIGH となり、次の入力オン信号(L→H)より出力動作を開始します。(V<sub>CC</sub> 電源電圧立ち上げ時同様)



$V_{CC}$  電源電圧が UVトリップ電圧( $V_{CCuvt}$ )より低下した状態が継続すると、UV フィルター時間経過後に FO 出力を LOW とすると共に、HO\*出力を LOW とします。 $V_{CC}$  電源電圧が UV リセット電圧より高くなると、FO パルス時間経過後、FO 出力が HIGH となり、次の入力オン信号(L→H)より出力動作を開始します。(V<sub>CC</sub> 電源電圧立ち上げ時同様)  
(LIN\*入力: "L"時、V<sub>CC</sub> > V<sub>BS</sub>)



$V_{BS}$  電源電圧が UVトリップ電圧( $V_{BSuvt}$ )より低下した状態が継続すると、UV フィルター時間経過後に HO\*出力を LOW とします。 $V_{BS}$  電源電圧が UV リセット電圧より高くなると、次の入力オン信号(L→H)より出力動作を開始します。この時、FO 出力は、HIGH を保持します。

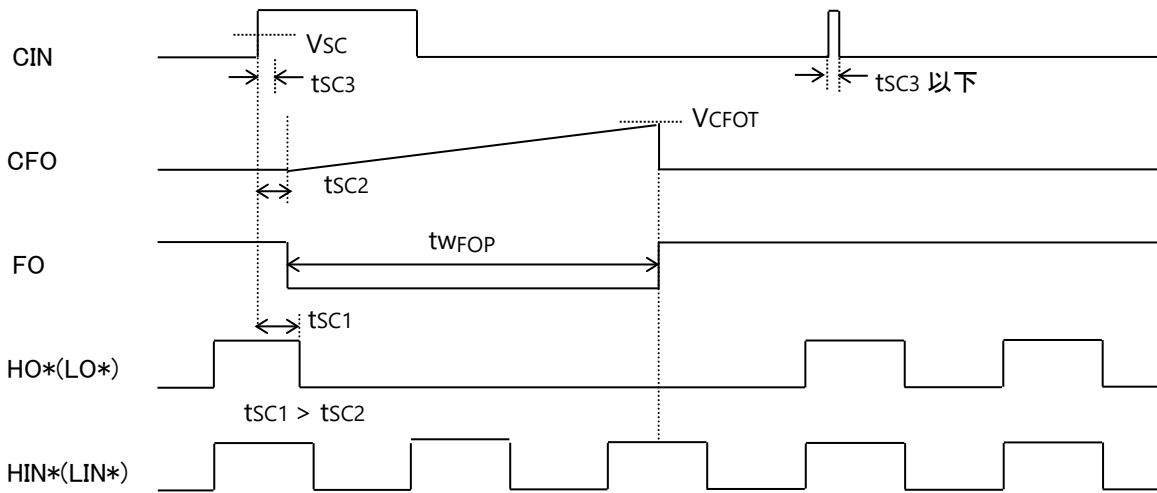


# M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

### 3. SC 保護動作

HIN\*(もしくは LIN\*)が HIGH の状態において、CIN に SCトリップ電圧( $V_{SC}$ )以上の電圧が SC フィルタ時間以上印加されると、短絡保護回路が動作し、FO 出力を LOW とすると共に HO\*出力(もしくは LO\*)を LOW とします。FO パルス時間経過後、FO 出力が HIGH となり、次の入力オン信号(L→H)より出力動作を開始します。



※FO パルス幅時間設定は以下の算出式(概略)になります。

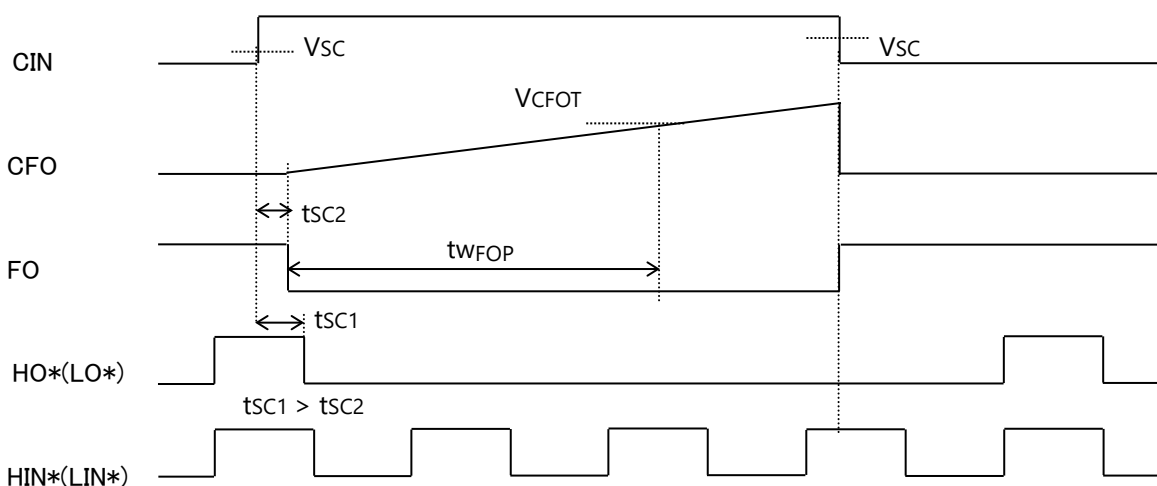
$$twFOP = C(\text{CFO 外付けコンデンサ}) \times V_{CFOT} \div I_{CF0}$$

計算例: CFO 外付けコンデンサ 22nF の場合

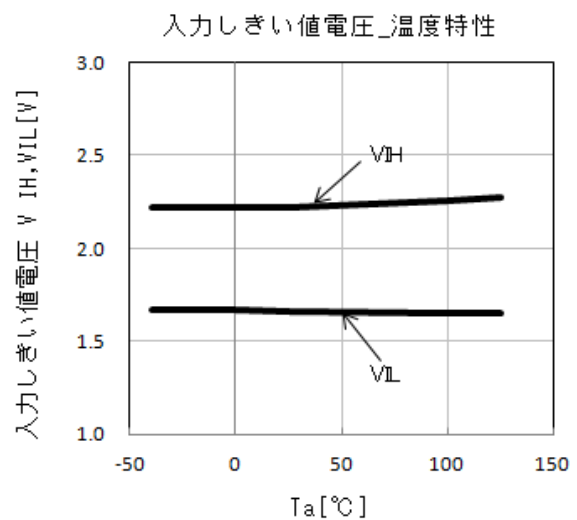
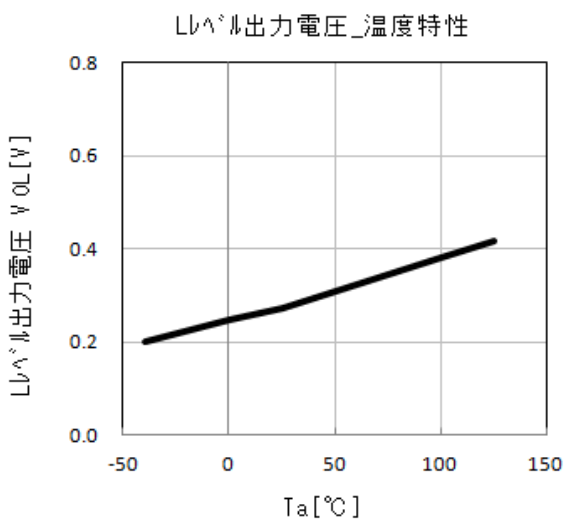
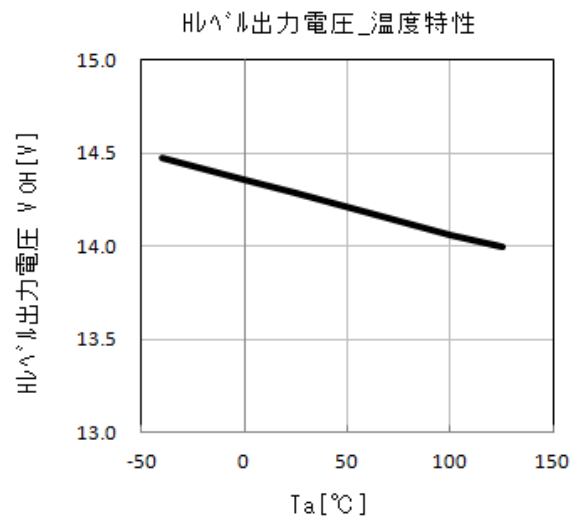
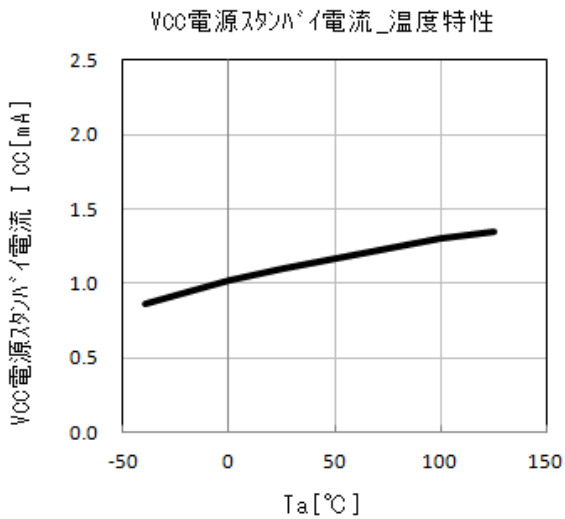
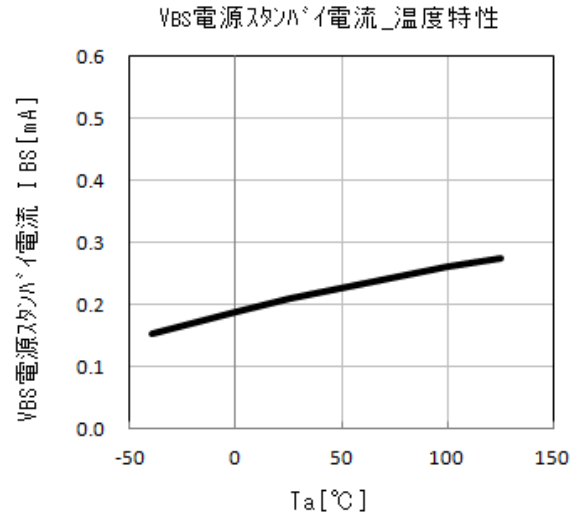
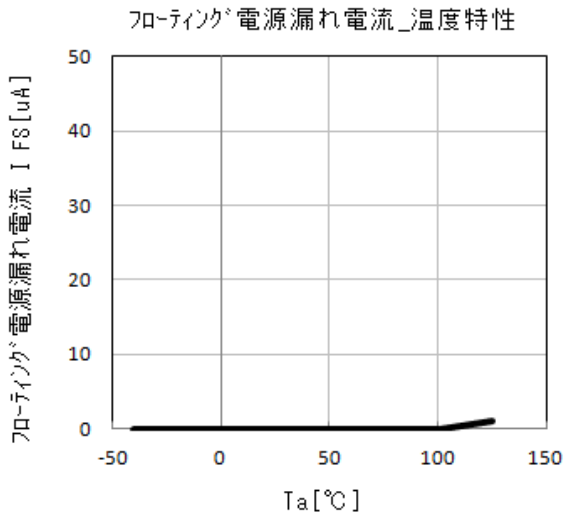
$$twFOP(\text{typ}) = C(22\text{nF}) \times V_{CFOT}(5.0\text{V}) \div I_{CF0}(10\mu\text{A}) = 11\text{ms}$$

※FO パルス時間経過後の FO 出力が LOW から HIGH となるタイミングで、CIN が SCトリップ電圧( $V_{SC}$ )以上の場合、FO 出力は LOW を保持します。

この場合、CIN が SCトリップ電圧( $V_{SC}$ )以下となったタイミングで、FO 出力が LOW から HIGH となり、次の入力オン信号(L→H)より出力動作を開始します。

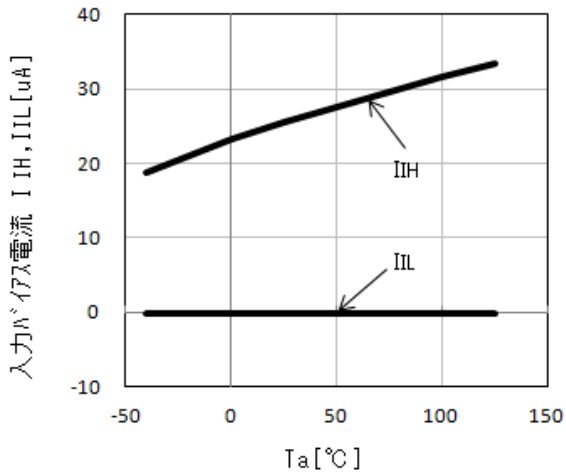


特性曲線 (\*:U,V,W 相を示す)

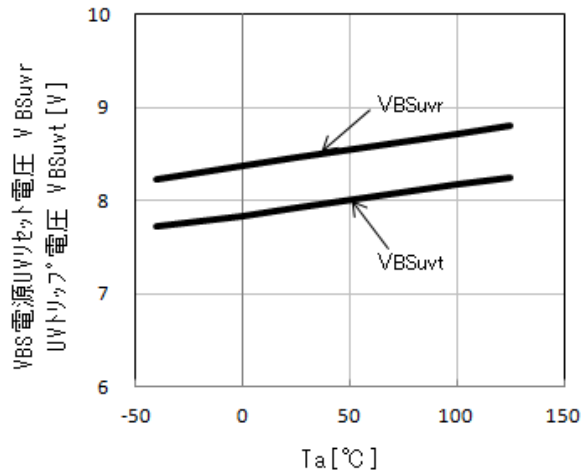




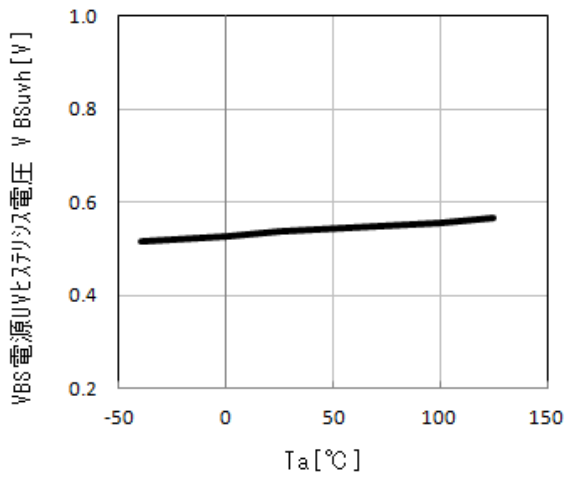
入力パルス電流\_温度特性



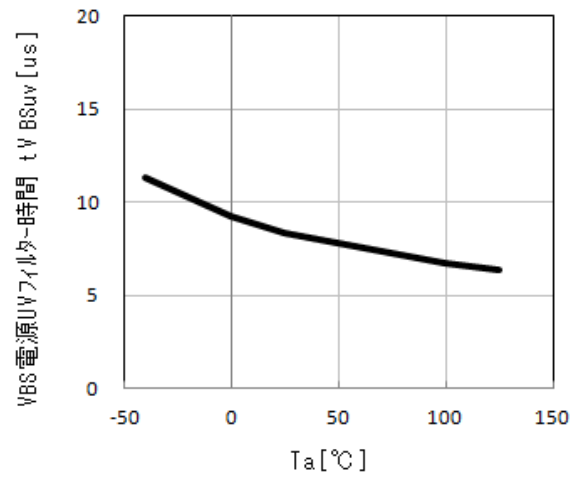
VBS電源UVリセット電圧, UVトリップ電圧\_温度特性



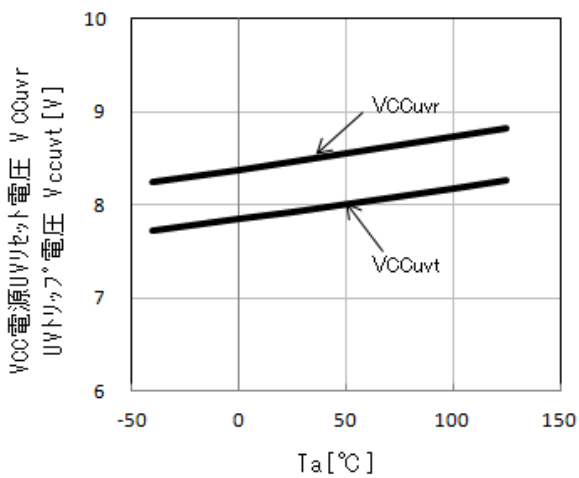
VBS電源UVヒステリシス電圧\_温度特性



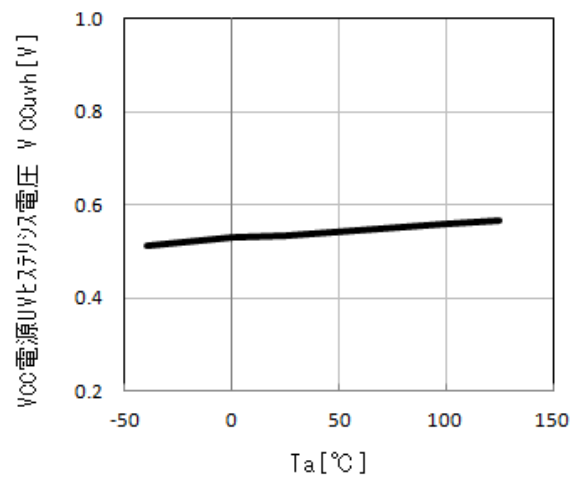
VBS電源UVフィルタ時間\_温度特性



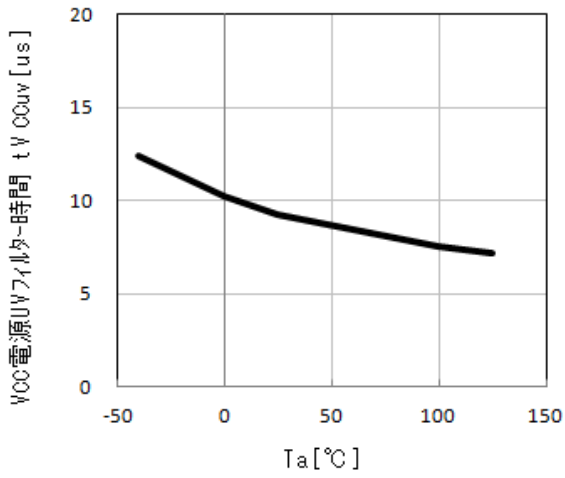
VCC電源UVリセット電圧, UVトリップ電圧\_温度特性



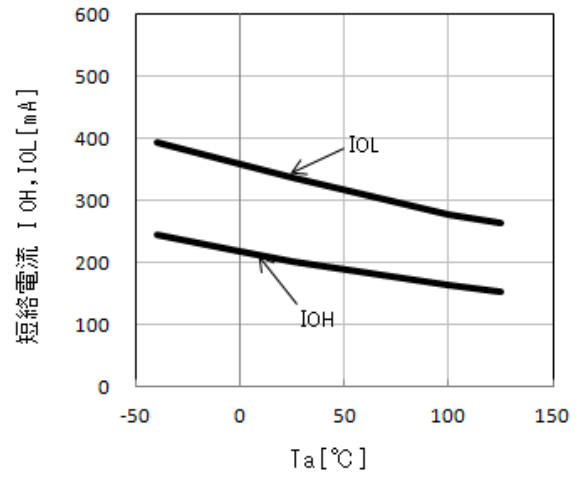
VCC電源UVヒステリシス電圧\_温度特性



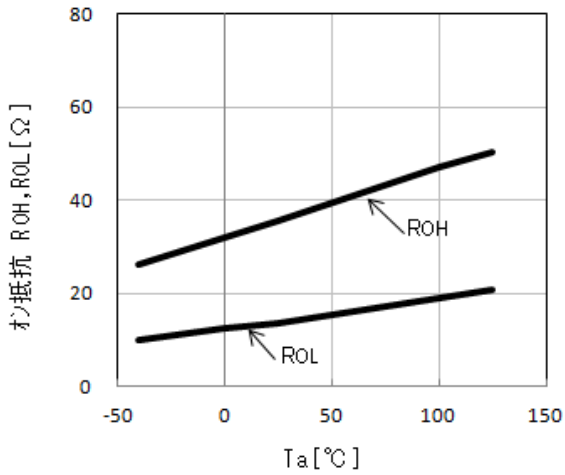
Vcc電源UVフィルタ-時間\_温度特性



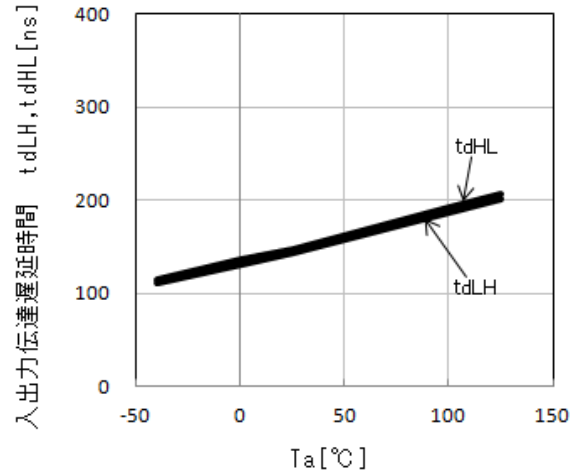
短絡電流\_温度特性



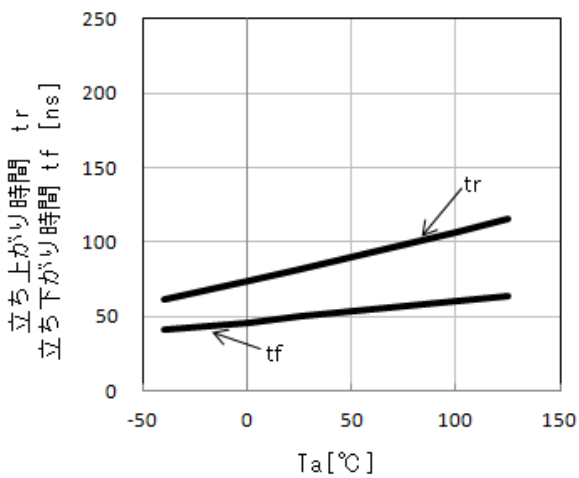
オン抵抗\_温度特性



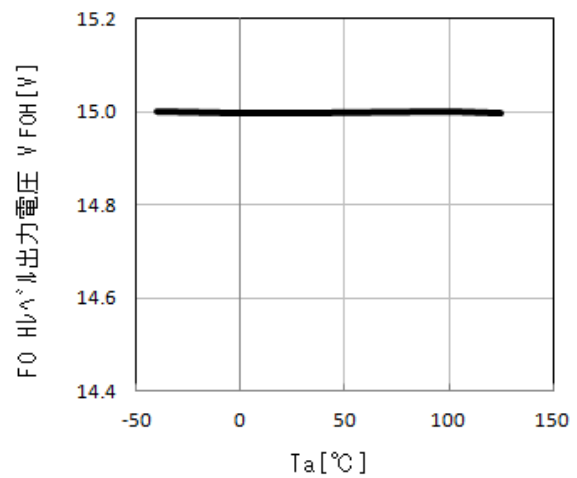
入出力伝達遅延時間\_温度特性

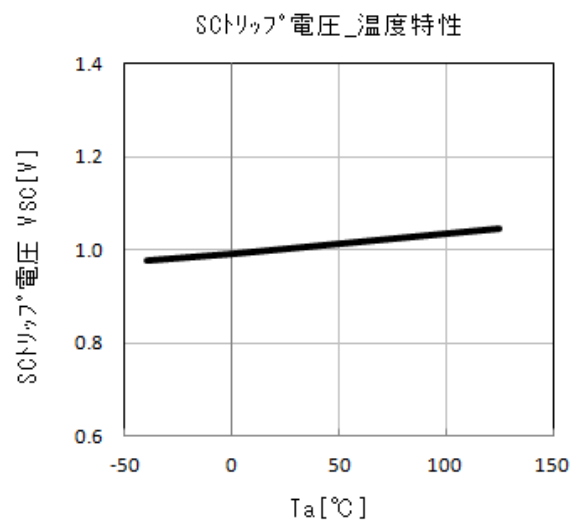
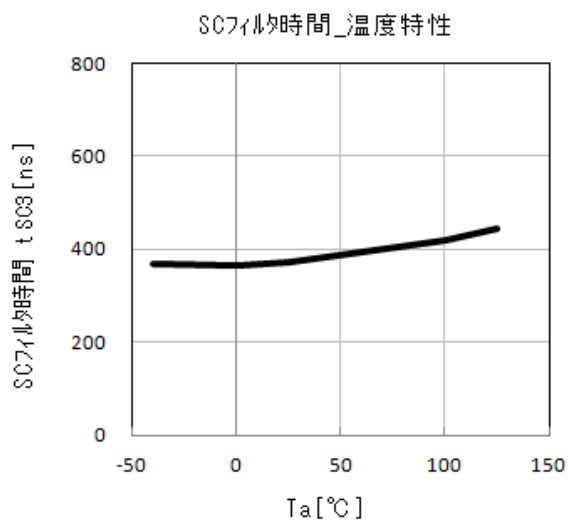
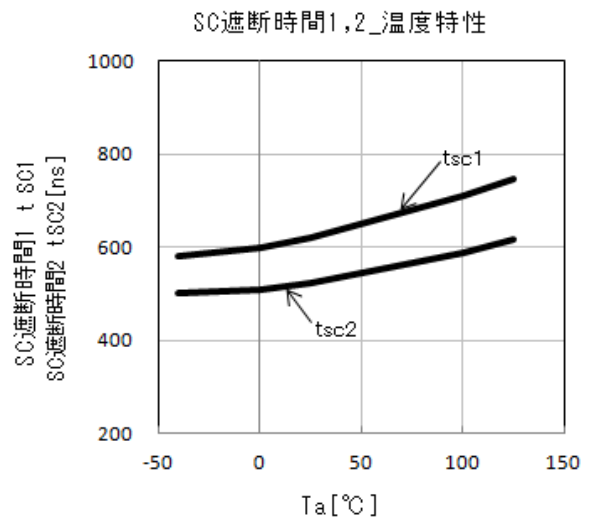
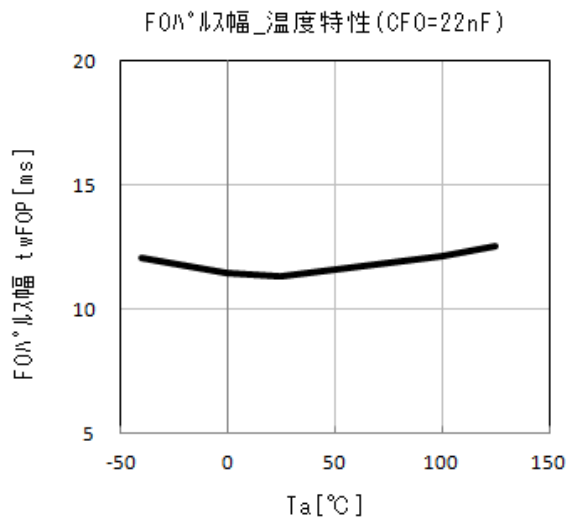
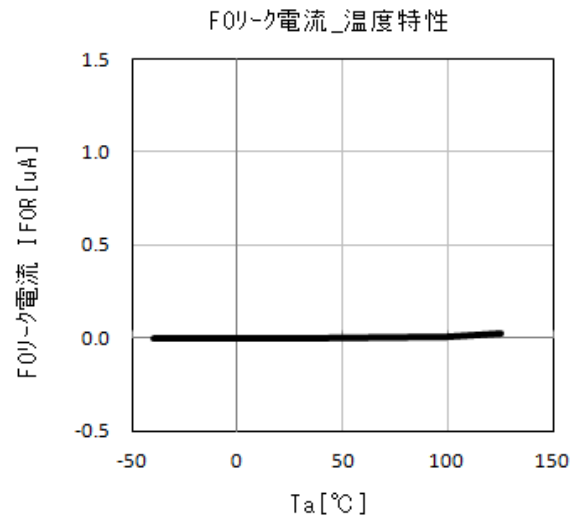
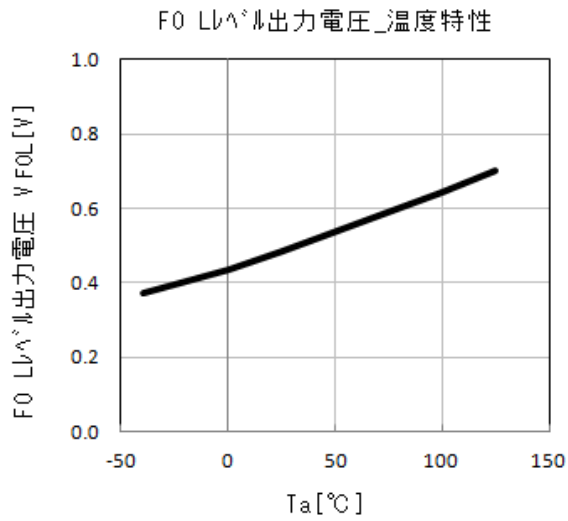


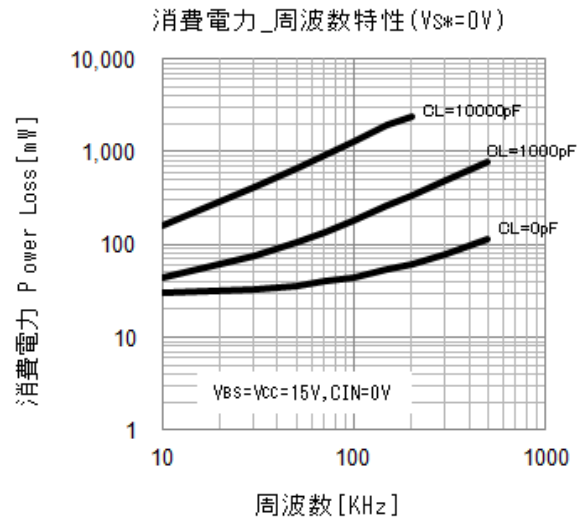
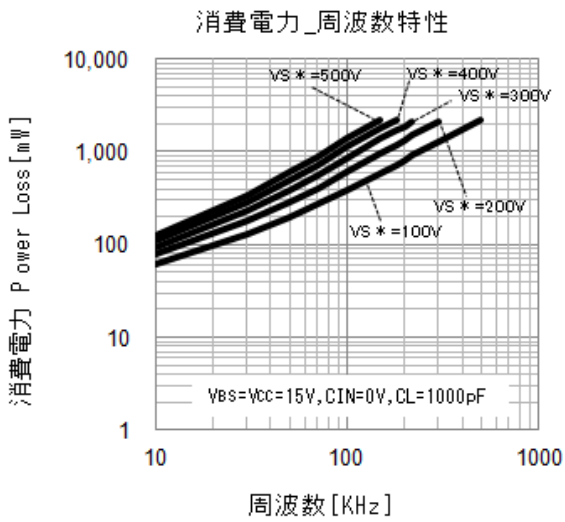
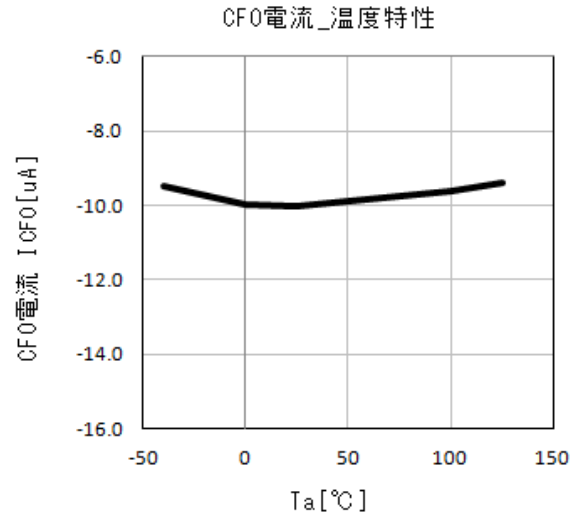
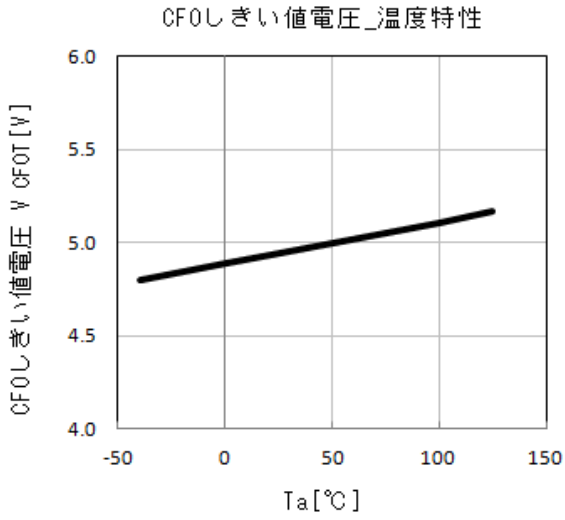
立ち上がり時間,立ち下がり時間\_温度特性



F0レベル出力電圧\_温度特性







# M81749FP

600V 高耐圧 3 相ブリッジドライバー

## 注意事項 (\*:U,V,W 相を示す)

### (1)電源立上げ順序

$V_{CC}$ ,  $V_{BS}$  の順序で立ち上げ、 $V_{BS}$ ,  $V_{CC}$  電源の順序で立ち下げることを推奨します。尚、 $V_{CC}$ ,  $V_{BS}$  電源の立ち上げ時には緩やかな傾きで立ち上げて下さい。急激な立ち上げですと出力が HIGH で立ち上がる場合があります。この立ち上げ、立ち下げの順序は推奨であり、これ以外の順序だと必ずしも問題があるわけではございません。

### (2)電源遮断時および再投入時

$V_{CC} < 10V$  時は出力が入力信号に応答しないホールド状態になる可能性があります。ご使用にあたりましては、アプリケーションシステムでの十分な評価をお願いします。

### (3) $V_{B*}$ の電位取り扱い

$V_{B*}$  電位は推奨動作条件範囲内  $V_{S*} + 10V < V_{B*}$  までのご使用をお願いします。それ以外の条件でのご使用時は、 $HO*$  出力が誤った論理で出力することがあります。ご使用にあたりましては、アプリケーションシステムでの十分な評価をお願いします。

### (4)IC 端子間処理

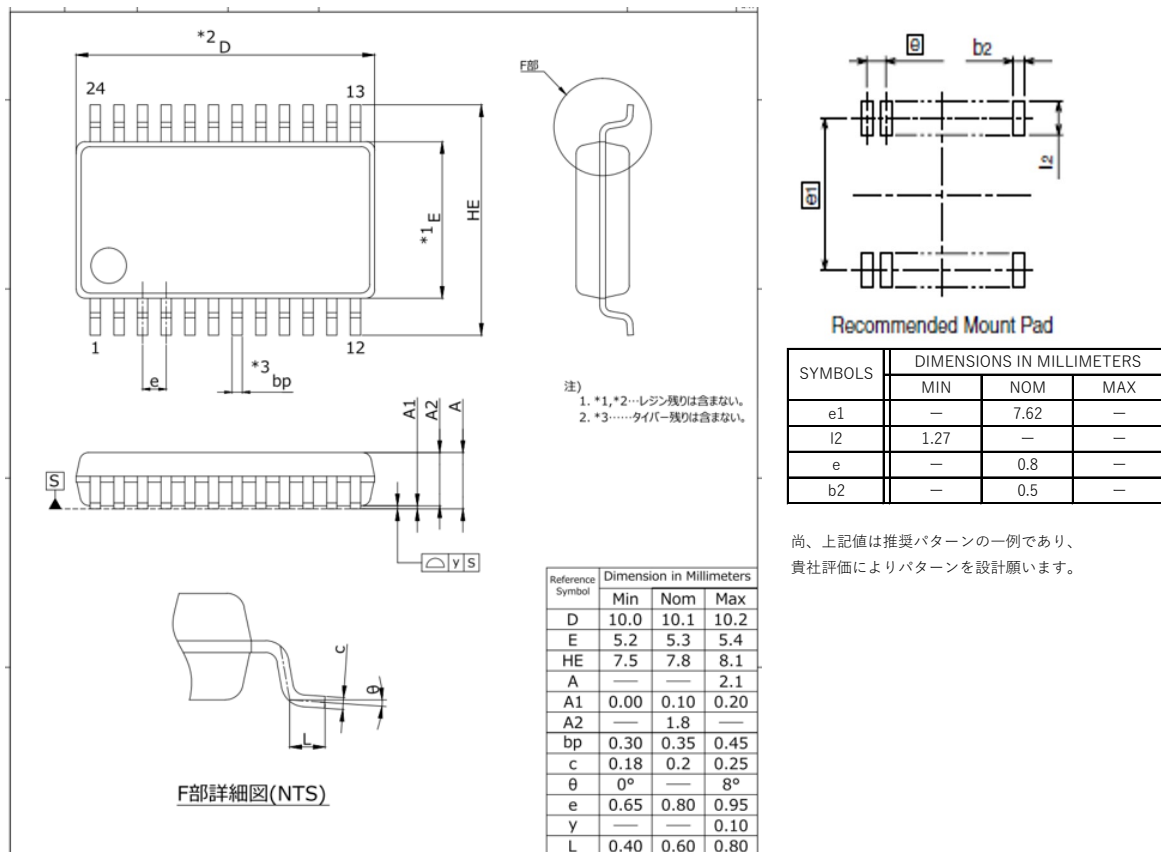
本製品は、低電圧部と高電圧部の端子が、NC 端子を挟んだ配置となっております(14 番:  $LO_U$  端子と 16 番:  $V_{SW}$  端子)。また、高電圧出力部の 3 相間において、低電圧時と高電圧時が隣接する状態が発生します(18 番:  $V_{BW}$  端子と 19 番:  $V_{SV}$  端子、21 番:  $V_{BV}$  端子と 22 番:  $V_{SU}$  端子)。そのため端子間の絶縁空間距離が十分取れない場合があります。本 IC をご使用の際は、端子間をコーティングするなどの対応をお願いします。

## 環境への配慮

本製品は RoHS※指令(2011/65/EU+(EU)2015/863)に準拠しています。

※Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and electronic equipment

## 外形図





### 特記事項

本資料に記載されている情報は、いかなる場合でも、条件、特性及び品質を保証するものではありません。弊社半導体製品は必ず本資料に記載された最大定格の範囲内でご使用いただき、また、適用される法令による要求、規範及び基準をお客様が遵守することを前提としております。

なお、弊社の権限を有する者が署名した書面による明示の承諾がある場合を除き、人身事故を招くおそれのある用途に弊社半導体製品を使用することはできません。

ドライバ IC は、長期の信頼性（温度サイクル等）について寿命を有していることや、組み立て時のストレス（はんだ付け時の高温、はんだ付け後の洗浄等）や、特定の動作条件（電源電圧の立上り/立下り時間、過大な電圧/電流の印加等）及び特殊環境下（結露、高湿度、高粉塵、高塩分、高地、有機物・腐食性ガス・爆発性ガスが多い環境、端子部等への過度な応力等）での使用により、故障が発生したり、誤動作したりする場合がありますので、十分ご注意ください。また、技術的要件によっては弊社半導体製品に環境規制物質等が含まれる可能性があります。詳細確認を要する場合には、最寄りの弊社営業所、あるいは代理店までお問い合わせください。

本資料の内容・データは、専門技術・教育を受けられた技術者を対象としています。弊社半導体製品のお客様用途への適合性及び適合性に関する弊社製品データの完全性については、お客様の技術部門の責任にて評価・判断してください。なお、貴社製品への適用検討にあたって、弊社半導体製品単体で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、適用可否をご判断ください。必要に応じ、高圧/大電流電源とパワー半導体製品 (IGBT, MOSFET 等) の間に適切な容量のヒューズまたはブレーカーを取り付けて二次破壊を防ぐなど、安全設計に十分ご注意ください。関連するアプリケーションノート・技術資料も合わせてご参照ください。

## 安全設計に関するお願い

弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

## 本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機または、第三者に帰属する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入にあたりましては、事前に三菱電機または代理店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ ([www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/)) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したのですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または代理店へご照会ください。
- 半導体・デバイスサイトに含まれる製品や技術をお客様が他の国へ提供する場合は、日本およびその他の国の輸出管理規制等を遵守する必要があります。また、日本、その他の仕向け地における輸出管理規則に抵触する迂回行為や再輸出は禁止します。
- 本資料の一部または全部の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたら三菱電機または代理店までご照会ください。